

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование				Кол.	Примечание																																	
		Устройства																																						
		A1	VRB4812ZP-6WR3 ф. MORNSUN				1																																	
		A2	GeoS-5M ф. Geostar				1																																	
		Преобразователи неэлектрических величин																																						
Справ. №	BL1	TEMDS5510FX01				1																																		
	BL2	APA3010P3BT				1																																		
	Конденсаторы																																							
	C1	керам., чип 0603, NPO, 50В, 1нФ ±0.1нФ				1																																		
	C2	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%				1																																		
	C3	ECHU1H184GX9 ф. Panasonic (плён., чип 2416, PPS, 50В, 0.18мкФ ±2%)				1																																		
	C4	GRM32EC81C476KE15 ф. Murata (керам., чип 1210, X6S, 16В, 47мкФ ±10%)				1																																		
	C5	593D476X9016C ф. Vishay (тант., чип С, 16В, 47мкФ ±10%)				1																																		
	C6	B41858C9477M ф. EPCOS (алюм. эл-лит, рад. 18*35мм, 100В, 470мкФ ±20%, низк. имп.)				1	не старше 1 года																																	
Подп. и дата	C7	A755MS108M1CAAE012 ф. KEMET (алюм. полим., рад. 10*12мм, 16В, 1000мкФ ±20%)				1																																		
	C8	Конденсатор К58-26 – 2,7В – 100Ф (+50...-20)% – ЕВАЯ.673811.006ТУ ф. АО «Электонд» (ионистор, рад. 20*40мм, 2.7В, 100Ф +50...-20%)				1																																		
	C9-C13	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%				5																																		
	C14-C18	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%				5	не устанавливать																																	
Инв. № дубл.	C19-C21	керам., чип 0603, X7R, 16В, 1мкФ ±10%				24																																		
	C22.1	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.01мкФ ±10%				1																																		
	C22.2	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.022мкФ ±10%				1																																		
	C22.3	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.033мкФ ±10%				1																																		
Взам. инв. №	C22.4	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.047мкФ ±10%				1																																		
	Изм.					Лист					№ докум.					Подп.					Дата					ВСAD.123456.001 ПЭЗ														
	Изм.					Лист					№ докум.					Подп.					Дата																			
	Изм.					Лист					№ докум.					Подп.					Дата																			
Подп. и дата	Разраб.	Иванов И.И.				19.01.2025	ВоМ Converter отладочный проект AD										Лит.			Лист			Листов																	
	Проверил	Петров П.П.				19.01.2025														1			7																	
	Н. контр.	Зюзина В.Н.				19.01.2025	Перечень элементов										ООО "НИИ БАЦА"																							
	Утв.	Горшков А.С.				19.01.2025																																		

Поз. обозначе- ние	Наименование	Кол.	Примечание
C22.5	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.056мкФ ±10%	1	
C22.6	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.068мкФ ±10%	1	
C22.7	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
C22.8	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.082мкФ ±10%	1	
C23.1	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.01мкФ ±10%	1	
C23.2	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.022мкФ ±10%	1	
C23.3	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.033мкФ ±10%	1	
C23.4	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.047мкФ ±10%	1	
C23.5	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.056мкФ ±10%	1	
C23.6	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.068мкФ ±10%	1	
C23.7	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
C23.8	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.082мкФ ±10%	1	
C24.1	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.01мкФ ±10%	1	
C24.2	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.022мкФ ±10%	1	
C24.3	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.033мкФ ±10%	1	
C24.4	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.047мкФ ±10%	1	
C24.5	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.056мкФ ±10%	1	
C24.6	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.068мкФ ±10%	1	
C24.7	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.1мкФ ±10%	1	не устанавливать
C24.8	керам., чип 0603, X7R, 50В, 0.082мкФ ±10%	1	
	Микросхемы		
DA1	МОС3063М (детектор нуля)	1	
DA2	TPS561201DDC ф. Texas Instruments	1	
	доп. замена TPS562201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 2А)		
	доп. замена TPS563201DDC ф. Texas Instruments (огр. тока 3А)		
DA3	LP5907MFX-3.3 ф. Texas Instruments	1	
DD1	SN74LVC1G126DBV ф. Texas Instruments	1	
DD2	SCM3725ASA ф. MORNSUN	1	
DD3	ECS-3225MV-250-CN ф. ECS Inc. (кварц, 25МГц ±25ppm, -40...+85°С)	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

BCAD.123456.001 ПЭЗ

Лист
2

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
										Элементы разные					
										EF1	SMTSO-M2-2ET ф. PEM (стойка, SMD, M2*0.4, 2мм)	1			
										ER1	FK 244 13 D2 PAK ф. Fischer Elektronik	1			
										Устройства защитные					
										FP1	MF-MSMF014 ф. Bourns (самовосст., чип 1812, 140мА, 60В)	1			
										FU1	0451001. ф. Littelfuse (плавкий, чип 2410, 1А, 0.6029А ² с, быстрый)	1			
										FU2	ZH242 (держатель)	1			
										FU3	ZH250 (держатель)	1			
										FU4	ZH242 (держатель)	1			
										FU5	ZH250 (держатель)	1			
										FV1	B72540T0400K062 ф. TDK (варистор, чип 2220, 68В, 9Дж)	1			
										FV2	SMBJ6.5CA (супрессор, двунаправ., 6.5В, 600Вт [10/1000мкс], корпус SMB)	1			
										FV3	SMBJ5.0A (супрессор, однонаправ., 5В, 600Вт [10/1000мкс], корпус SMB)	1			
										FV4	GSOT05C-E3-08 (супрессор, корпус SOT-23)	1			
										FV5	CDSOT23-T24CAN ф. Bourns (супрессор, корпус SOT-23)	1			
										Генераторы, источники питания					
										GB1	CR 1/2 AA S PCBD ф. VARTA	1			
										GB2	BR-2325/2HAN	1			
										GB3	DS1092-04-B6P ф. Connfly (держатель, , CR2032)	1			
										доп. замена BH-25F-1 ф. Adam Tech					
										доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices					
										GB4	BH-25F-1 ф. Adam Tech (держатель, , CR2032)	1			
										доп. замена DS1092-04-B6P ф. Connfly					
										доп. замена BS-7 ф. Memory Protection Devices					
										Устройства сигнальные					
										HG1	CC56-12SRWA ф. Kingbright	1			
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		BCAD.123456.001 ПЗЗ				Лист	
														3	
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата										

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание	
HL1		KP-1608F3C ф. Kingbright (инфракрасный, 940нм, 150град.)			1		
HL2		KPT-1608SURCK (красный, 645/630нм, 230мкд [20мА], 120град.)			1		
HL3		KPA-3010CGCK (зелёный, 574/570нм, 50мкд [20мА], 120град.)			1		
HL4		KPT-1608QBC-D (синий, 460/465нм, 100мкд [20мА], 130град.)			1		
HL5		KPT-1608SYCK (жёлтый, 590нм, 150мкд [20мА], 120град.)			1		
HL6		XPCWHT-L1-0000-008E5 ф. Cree (белый, 4000К, CRI75, 73.9лм [350мА])			1		
HL7		SMP6-RGB ф. Bivar (многоцветный)			1		
HL8		KPBDA-3020SURKCGKC-PF ф. Kigbright (многоцветный, сборка)			1		
HL9		AM23ESGW ф. Kingbright (многоцветный, сборка)			1		
J1		Перемычка чип 0402			1		
		Реле					
K1		RZ03-1A4-D012 ф. TE Connectivity			1		
K2		T9GV2L24-12 ф. TE Connectivity			1		
K3		RT214012 ф. TE Connectivity			1		
K4		V23105A5476A201 ф. TE Connectivity			1		
		Катушки индуктивности					
L1		чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА			1		
L2		SRU1048-470Y ф. Bourns (47мкГн ±30%, 1.5А)			1		
L3-L5		чип 1812, 10мкГн ±10%, 250мА			3		
L6-L8		SRU1048-470Y ф. Bourns (47мкГн ±30%, 1.5А)			3		
L9, L10		SRN6045TA-2R2Y ф. Bourns (2.2мкГн ±30%, 6А)			2		
L11		SRR0604-100ML ф. Bourns (10мкГн ±20%, 1.3А)			1		
L12		SRN6045TA-2R2Y ф. Bourns (2.2мкГн ±30%, 6А)			1	не устанавливать	
		Резисторы					
R1		чип 0603, 10кОм ±5%			1		
R2		чип 0603, 47кОм ±0.5%, ±25ppm/°C			1		
R3		RV0805JR-071ML ф. YAGEO (чип 0805, 400В, 10кОм ±5%)			1		
R4-R7		чип 0603, 100кОм ±1%			4		
Инв. № подл.					BCAD.123456.001 ПЗЗ		Лист
							4
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			Дата

BCAD.123456.001 ПЭЗ

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание
R8		чип 0603, 200кОм ±1%			1	
R9-R12		чип 0603, 300кОм ±1%			4	
R13		чип 0603, 470кОм ±5%			1	
R14-R19		чип 0603, 1кОм ±1%			36	
R17.5-R17.8		чип 0603, 4.7кОм ±1%			4	
R18.5-R18.8		чип 0603, 4.7кОм ±1%			4	
R19.5-R19.8		чип 0603, 4.7кОм ±1%			4	
RK1		NCP18XQ102J03RB ф. Murata (чип 0603, 1кОм ±5%)			1	
RK2		TFPT0805L1000FV ф. Vishay (чип 0805, 1000м ±1%)			1	
RP1		3006P-1-103 ф. Bourns (10кОм ±10%, , подстроечный, лин. хар-ка)			1	
		Устройства коммутационные				
SA1		CHS-01TA ф. Copal Electronics Inc.			1	
SA2		SWD-08L			1	
SA3		MS-22D18 (двухжкобий)			1	
SA4		GPTS203211B ф. CW Industries			1	
SA5		SSSF012100			1	
SA6		PN12SHNA03QE ф. C&K			1	
SB1		DTSM-61N ф. Diptronics (кнопочный)			1	
T1		Трансформатор HX1188NL ф. Pulse			1	
		Диоды				
VD1		BAS316 (100В, 250мА, корпус SOD-323)			1	
VD2		BAT20JFILM (Шоттки, 23В, 1А, корпус SOD-323)			1	
VD3		BZT52H-B13 (13В ±2%, 830мВт, корпус SOD-123F)			1	
VD4		BB545E7904 ф. Infineon			1	
VD5		BAT54AFILM (Шоттки, 40В, 300мА, корпус SOT-23)			1	
VD6		BAT54CFILM (Шоттки, 40В, 300мА, корпус SOT-23)			1	
VD7		BAT54SFILM (Шоттки, 40В, 300мА, корпус SOT-23)			1	
Инв. № подл.					BCAD.123456.001 ПЭЗ	
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата	Лист
						5

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание	
		Тиристоры					
VS1					1		
VS2		TYN412RG ф. STMicroelectronics (400В, 12А, 15мА)			1		
VS3		TMMDB3TG ф. STMicroelectronics (двунаправ., 32В, 2А, 15мкА)			1		
VS4		BTA24-600BWRG			1		
		Транзисторы					
VT1		BCR108 (диполярный цифровой)			1		
VT2		IRLML2030			1		
VT3		BC817			1		
VT4		BCR158 (диполярный цифровой)			1		
VT5		IRLML5103			1		
VT6		BC807			1		
VU1		Оптомара LTV-357T			1		
Подп. и дата							
			Соединители				
	X1		15EDGRC-3.5-04P ф. Degson			1	
	X2		5035000993 ф. Molex			1	
			доп. замена 5035000991				
Инв. № дубл.	X3		292303-1 ф. TE Connectivity			1	
			Фильтры				
Взам инв. №	ZC1		WCM4532F2SF-142T20-HI ф. TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd.			1	
			(синф. дроссель, 1.4кОм [100МГц], 100мОм, 2А)				
	ZF1		MMZ1608B102C ф. TDK (фер. дус., чип 0603, 1кОм ±25% [100МГц], 600мОм, 300мА)			1	
Подп. и дата	ZQ1		FY0800018 ф. Diodes Incorporated (кварц., 8МГц ±30ppm, фунд., 18пФ, 1000м, -40...+85°C)			1	
	ZQ2		ABS07-32.768KHZ-T ф. Abracon (кварц., 32.768кГц ±20ppm, 12.5пФ, 70кОм, -40...+85°C)			1	
Инв. № подл.					BCAD.123456.001 ПЭЗ		Лист
							6
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			Дата

[illegible]